

公司簡介

一、設立日期：民國八十六年六月二日

二、公司沿革

86年06月	聯亞光電工業股份有限公司成立，資本額新台幣60,000仟元。
86年09月	辦理現金增資新台幣40,000仟元，增資後實收資本額為新台幣1億元。
87年11月	工廠啟用，座落台南市永康區中正路217巷1號。
88年03月	光纖通信用LD及PD磊晶片，通過客戶品質認證。
88年07月	辦理現金增資新台幣97,000仟元，增資後實收資本額為新台幣197,000仟元。 永康廠通過ISO9001品質管理認證。
88年10月	GaAs/InGaP PD磊晶片，通過客戶品質認證。
89年03月	辦理現金增資新台幣120,000仟元，增資後實收資本額為新台幣317,000仟元。
89年07月	永康廠通過ISO14001認證。
92年01月	研發出850nm VCSEL磊晶片。
92年06月	通過國科會提昇產業技術及人才培育研究計畫「以矽為基板之氮化鎵材料及元件之研究」。 盈餘轉增資新台幣13,840仟元，實收資本額為新台幣330,840仟元。
92年10月	通過經濟部業界開發產業技術計畫-「10Gbps Optical Transponder模組及相關高速元件研究計畫」。 永康廠通過ISO 9001:2000品質管理認證。
93年02月	工研院委任執行「高功率LD磊晶再成長技術」研究計畫。
94年01月	辦理減資彌補虧損新台幣211,710仟元及債權轉增資新台幣173,442仟元，實收資本額變更為新台幣292,572仟元。
95年07月	通過經濟部小型企業研發計畫-「金屬有機化學氣相沉積法製備量子井紅外線偵測器磊晶片之研究」。
95年10月	黃光室PIN與BH-LD前段製程研發完成。
96年04月	研發Triple-junction Solar Cell高效率太陽能磊晶片。
96年06月	辦理減資彌補虧損新台幣58,514仟元，實收資本額變更為新台幣234,058仟元。

97年01月	合併台傑光電股份有限公司，增加股本新台幣 70,010 仟元，實收資本額變更為新台幣 304,068 仟元。
98年01月	量產 Completed DFB &BH 磊晶片。
99年07月	辦理現金增資新台幣 10,000 仟元，增資後實收資本額增加為新台幣 314,068 仟元。 於南部科學工業園區投資增建新廠。
100年06月	盈餘及員工紅利轉增資新台幣 26,703 仟元，實收資本額變更為新台幣 340,771 仟元。
100年12月	南部科學工業園區新建工廠完成，遷址南部科學工業園區繼續營業。(台南市善化區南科九路 12 號)
101年06月	辦理盈餘及員工紅利轉增資，新台幣 25,509 仟元，實收資本額變更為新台幣 366,280 仟元。
101年07月	南科廠通過 ISO9001 和 ISO14001 認證。
102年05月	辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣 86,136 仟元，實收資本額變更為新台幣 452,416 仟元。
103年03月	辦理股票公開發行。
103年05月	辦理盈餘及員工紅利轉增資新台幣 100,475 仟元，實收資本額變更為新台幣 552,891 仟元 成立審計委員會及薪酬委員會
103年07月	櫃檯買賣中心核准登錄興櫃掛牌。
104年07月	辦理掛牌前公開承銷現金增資新台幣 1,540,560 仟元，實收資本額增加至新台幣 607,911 仟元 於證券櫃檯買賣中心掛牌為上櫃股票。
104年09月	辦理盈餘轉增資新台幣 91,187 仟元，實收資本額變更為新台幣 699,098 仟元。